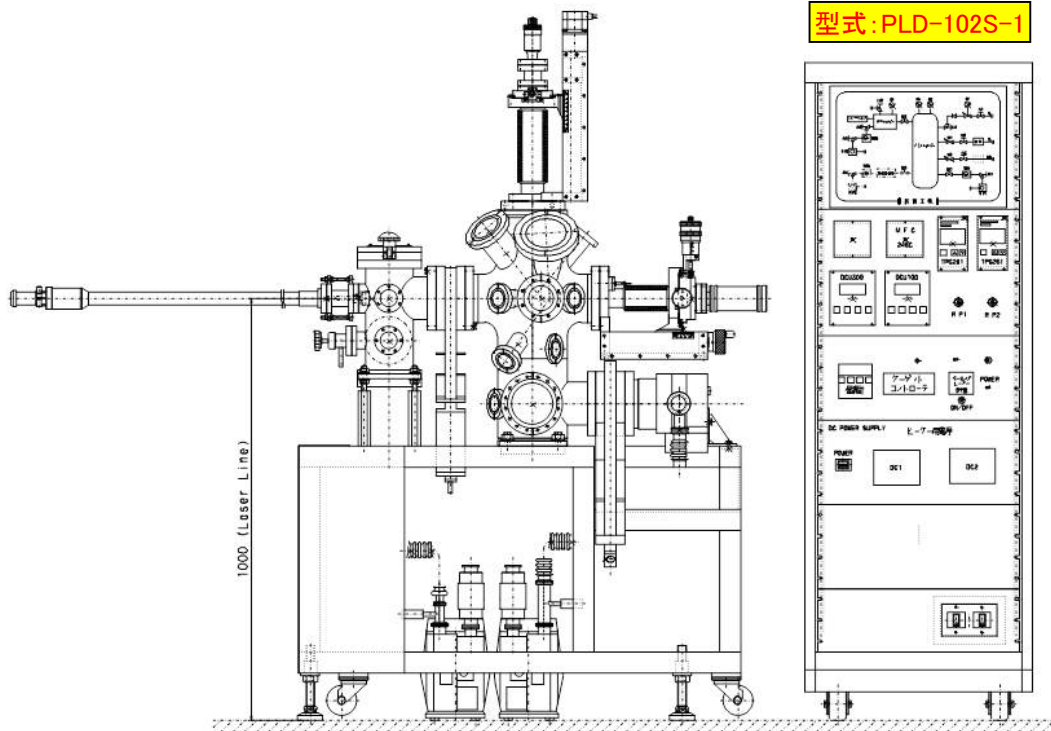


PLD 装置

Pulsed Laser Deposition System



装置の詳細仕様、バリエーションに関してはお気軽にお問合せ下さい。

装置名称	PLD 装置 (Laser MBE, Si通電加熱)	備考
型式	PLD-102S-1 (成膜室+準備室+RHEED+ソフト)	
仕様	成膜室: 寸法160(ID)X550(H) mm, 電解研磨	シースヒーター巻き
	ターゲット: φ10x5t ,5個(汚れ防止有)	上下スキャン機構
	基板加熱: Si通電加熱,温度850°C以上	他の加熱方式選択可能
	基板: サイズ10x10, 温度800以上, 4軸マニピュレータ	基板サイズ変更可能
	成膜室真空度: 5X10 ⁻⁶ Pa以下	真空ポンプ変更可能
	ガス導入系: MFC+ストップバルブ, 2系統	必要に応じて変更可能
	その他: ロードロック機構, RHEED, イオン源	他の機構増設可能
	オプション: RHEED画像処理システム,膜厚計,成膜ソフト等	
設置及電源	外観寸法: 110(W)X80(D)X180(H) cm 電源: 単相 200V 50A	

株式会社 アンセイテック ANSEI TECH CO., LTD.
 TEL: 06-6707-5888 E-mail: info@anseitech.com